文章编号: 1000-4734(2009) 01-0109-04

# 高温高压下杂质离子对水晶电导率 影响的实验研究

单双明<sup>1,2</sup>,李和平<sup>1</sup>,代立东<sup>1</sup>,汪日平<sup>1,2</sup>

(1. 中国科学院 地球化学研究所 地球深部物质与流体作用实验室, 贵州 贵阳 550002; 2. 中国科学院研究生院,北京 100039)

摘要:杂质离子往往是影响水晶电导率的主要因素。在 2.0GPa和 823~1123 K的条件下,借助交流阻抗谱法 在  $10^{\circ} \sim 10^{\circ}$  H z频率范围内, 就位测量了水晶 Z 轴方向的电导率, 并用 LA-ICP-M S测试了水晶中杂质 N a A l的 含量。通过 Arrhenius关系拟合,得出 2.0 GPa和 823~1123 K条件下水晶的活化焓和指前因子。发现水晶中 杂质 Na A 的含量彼此正相关,水晶电导率与晶体中 Na含量正相关,且指前因子亦与水晶中杂质 Na A l含量 正相关。

关键词: 高温高压; 水晶; 电导率; 杂质离子

中图分类号: 0738 P579 文献标识码: A

作者简介: 单双明. 男. 1978年生. 博士研究生. 主要从事高温高压下矿物电学性质的实验研究..

高温高压实验一直是人们了解各种物质及体 系的成分、结构、性状和过程的重要手段。因此、 开展各种物质及体系的高温高压实验研究具有重 要的理论和实际意义<sup>[1-2]</sup>。石英是一种常见的矿 物,占地壳质量的 20%;此外,作为主要的造岩矿 物,其物理性质的研究可直接应用于热液矿床的 成因研究和矿床评价,具有极其重要的意义<sup>[3]</sup>。 以往对水晶的研究主要集中在弹性、压电性等性 质上,虽然王多君等<sup>[4]</sup>、代立东等<sup>[5]</sup>、Bagdassarov 和  $Del pine^{[0]}$ 做过水晶电导率方面的研究, 但主 要是实验方法以及温压条件对电导率影响的研 究。高温高压条件下水晶中杂质离子含量对其电 导率影响的实验研究国内外鲜见报道。 然而 石 英或水晶的宏观物理性质、微观晶格扩散以及表 面物理化学特征无一不受其中的晶格杂质点缺陷 的制约。不同温度压力下水晶电导率与杂质含量 关系的实验研究既具有重要的地球科学意义,其 结果一方面可为野外大地电磁测深反演地球内部 物质结构及物质组成提供基本的电性参数,另一 方面可为地质地球化学家们深入研究含石英岩石

收稿日期: 2007-07-08

基金项目: 国家 863计划项目 (2006AA 09Z205); 国家自然科学基 金项目(批准号: 40573046)

各矿物间在高温高压下的互扩散过程提供基本的 热力学与动力学参数:与此同时,不同温度压力下 水晶电学性质的实验研究还将为水晶的改色、除 杂和掺杂等改性工艺的研究,以及水晶的光学、压 电和介电特性的科学利用提供重要的科学依据。 本工作在 2.0 GPa和 823~ 1123 K 下借助交流阻 抗谱法在  $10^{1} \sim 10^{6}$  H z 频率范围内就位测量了水 晶 Z轴方向的电导率,并使用激光剥蚀电感耦合 等离子质谱仪 (LA-ICP-MS)测试了水晶中杂质 NaAI的含量,计算了水晶的活化焓和指前因子。

1 实验方法

本实验所用样品为中国科学院地球化学研究 所水晶制备厂生产,并选用其中沿 Z 轴方向生长 的水晶讲行实验。

1.1 电导率的测量

高温高压电导率测量实验在中国科学院地球 化学研究所的 Y 1-3000吨紧装式六面顶高温高压 实验装置和 Solartron-1260 阻抗 /增益-相位阻抗 谱分析仪 (1260FPIA)上完成、装置的操作与使用 原理见文献<sup>[7]</sup>。

实验前,沿晶体 Z 轴方向从水晶中连续切割 出 5个直径 6.0 mm, 高 4.0 mm 的圆柱体 (记为 © 1994-2012 China Academic Journal Electronic Pu



No.1 No.2 No.3 No.4 No.5), 并在无水乙醇中

用超声清洗 30min 取出后在 120 ℃烘箱中烘烤

Fig 1. Sample assemblage and data collection system.

实验样品组装和数据采集系统如图 1 所示。 实验中的外传压介质为烧结叶蜡石,烧结温度 973 K,烧结时间 8 h,内传压介质为生烧可切削氧 化铝,同时起到绝缘的作用。温度测量由 P t h<sub>10</sub>--P t 热电偶连接 H P 数字万用表 (图 1中 TC)完成。 实验采用恒压升温的方法进行,升压速率 0.5 GPa/h 升到 2.0 GPa后自动升温,升温速率 20 ℃/m in。温度升至预定值时稳定 15~20 m in 然 后用 1260FP A 在  $10^{1} ~ 10^{6}$  H z 频率范围内测量 系统的阻抗谱图,待多次测量重合后记录实验 数据。

1.2 微量元素 Na Al含量的测定

微量元素含量测量实验在西北大学大陆动力 学国家重点实验室的 LA-ICP-MS上完成, 仪器的 参数设置与操作见文献<sup>[8]</sup>。

实验前, 沿晶体 Z 轴方向从水晶中切出宽 15.0mm, 厚 2.0mm 的薄片 (长度从晶面到籽 晶)。用 1<sup>µm</sup>的金刚石粉对薄片进行双面打磨, 磨光后依次用低导去离子水清洗 3次, 5% 的稀硝 酸浸泡 12h, 5% 的稀硝酸超声清洗 30min, 去离 子水清洗 3次, 取出后用纯 Ar气吹干, 并用滤纸 包好待用。

实验中采用 H e作为剥蚀物质的载气。用美 国国家标准技术研究院研制的人工合成硅酸盐玻 璃标准参考物质 N IST 610对仪器进行校准, 使仪 器达到最佳性能。最佳化完成后即可进行含量测 量,测量时采样方式为点剥蚀,数据采集选用跳峰 方式 (peak jumping),剥蚀直径为 120  $\mu$ m。沿晶 体 Z 轴方向从晶面到籽晶每隔 1.5 mm 一个点进 行 LA-ICP-M S测定。元素含量计算以 Ca作为内 标,N ST610作为含量已知的标准物质。

2 实验结果与讨论

### 2.1 电导率结果与讨论

在压力为 2.0 GPa和温度为 823~1123 K的 条件下,每隔 50 K 一个温度点对各样品进行阻抗 谱测量。图 2为样品 N o 1的阻抗谱图,从图中可 知随着温度的升高,水晶的阻抗不断降低,这种趋 势与前人研究结果<sup>[45]</sup>一致;但是在阻抗数值上 与前人研究结果<sup>[46]</sup>有所差别(1~2个数量级), 这与样品的来源(主要为样品杂质含量)、几何参 数(即样品的厚度和横截面积)以及实验条件 (压力)的不同有关。



图 2 样品 No. 1的阻抗谱图 (p = 2.0 GPa Re[Z]为实部, m[Z]为虚部)



将阻抗谱图用 1260FPIA 自带的 Z-view 软件 进行等效电路拟合得到各样品不同温度下的电阻 R,将其代入公式:  $\sigma = (LS) / R$ , (其中  $\sigma$  为电导 率, L为水晶样品高度, S 为电极面积),即可得到 各样品不同温度下的电导率。

使仪 将  $\lg(\sigma T) = 1/T$ 作图 3,从图中可知,各点明 量测 Pub 最分成两组。 $\exists_1 N \circ_2 1$ 。 $N \circ_2 4$ 的电导案 明显低于  $i_1 n_2$  N o 2, N o. 3, N o. 5 的,这与样品中杂质的含量 有关。

图 3中  $g(\sigma T)$ 与 1/T有很好的线性关系,符 合 Arthenius关系<sup>[9]</sup>:

 $\lg(\sigma T) = \lg 4 - 0.4343 E /(\kappa T)$ 

其中:  $\sigma$ 为电导率, A 为指前因子,  $\kappa$ 为 Boltzmann 常数, T为热力学温度 (Kelvin), E 为活化焓。表 1列出了各电导率样品的 Arrhenius关系拟合参 数, 从表中可以看出, 不同样品的拟合指前因子 A 有 2个数量级的变化。



Fig 3. Conductivity pb ts  $( g(\sigma T) vs 1/T )$ 

of different samples

表 1 各样品的 Arthenius关系<sup>[9]</sup>拟合参数

Table 1. Sinulated parameters of Armenius relation

for	d	iffe rent	samp	$\mathbf{es}$
-----	---	-----------	------	---------------

样品	lg4	T /(K)	A /(SK /m)	E / (eV)	$r^2$
NO. 1	3 300	823~ 1123	1995. 262	0. 437	0. 9947
NO. 2	3 964	823~ 1123	9212. 977	0.479	0. 9971
NO. 3	4 194	823~ 1123	15620. 682	0. 501	0. 9974
NO. 4	3 290	823~ 1123	1949. 845	0.436	0. 9937
NO. 5	3 852	823~ 1123	7107.224	0.450	0. 9981

2.2 Na Al含量的结果及与电导率参数关系的讨论

由于样品杂质含量是每隔 1.5mm 一个点进 行 LA-ICP-M S测量的, 而阻抗谱测量所用样品在 从晶体上切下时厚度为 4mm, 因此, 各样品的杂 质含量不是直接使用 LA-ICP-M S数据, 而必须通 过计算求取。本工作采用的方法是:将电导率样 品所处位置范围内各剥蚀点的数据进行几何平 均, 视此平均值为各样品中 Na A I的含量, 结果列 于表 2.0 很明显, Na和, A I的含量变化趋势一致。

表 2 各样品的 Na Al含量

Table 2. The contents of N a and A l in various samples  $% \left( {{{\mathbf{A}}_{\mathbf{A}}}_{\mathbf{A}}} \right)$ 

样品	$w(Na) / 10^{-6}$	w (A)) /10 <sup>6</sup>
No. 1	0. 6953	2.7450
No. 2	2. 2868	5. 1953
No. 3	5. 1089	7.4178
No. 4	0. 9823	3.7435
No. 5	3. 3152	6.6282

将表 2的 Na Al含量换算成原子数,结果表 明 n(Na):n(Al) < 1:1, 说明水晶中可能还含有其它一价阳离子杂质, 这有待于进一步的研究, 下面仅对 Al<sup>3+</sup>、Na<sup>+</sup>加以讨论。

对比图 3和表 2 相同温压条件下水晶电导 率和杂质 Na A l的含量呈正相关关系。图 4为各 样品 left 和 Na A l含量关系,从图可知:①水晶中 Na A l的含量变化趋势一致;② left 的变化趋势与 Na A l含量的变化趋势一致。





在水晶的水热生长中采用  $N \ge O_3$  作为矿化 剂, 水晶中不可避免的引入了  $Na^+$  离子。 $Na^+$  离 子进入晶格后, 以填隙的形式进入晶格间隙, 由于 库仑力的作用,  $Na^+$  处在  $A^{3^+}$  的最邻近位置或次 邻近位置, 以形成  $[A^{3^+} - Na^+]$ 离子对<sup>[10]</sup>。

水晶的离子电导主要由  $[A^{3^{+}} - N a^{+}]$ 离子对 分解后的  $Na^{+}$ 离子引起, 且水晶电导率与  $Na^{+}$ 离 子浓度存在如下关系<sup>[11]</sup>:

 $\sigma = c N_0 e \mu$ 

其中:  $\sigma$ 为电导率, c为 N  $a^{+}$  离子浓度,  $N_{0}$  为单位 体积内硅原子数, e为电子电量,  $\mu$ 为 N  $a^{+}$  离子迁 移率。在相同温压条件下  $N_{\odot}$   $\mu$  为恒定值。此 外, 按照质量作用定律 [A  $I^{3+}$  -N  $a^{+}$ ]分解后的 N $a^{+}$ 

于表 1394-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House: All rights reserved. The provident the second state of the s

系<sup>[10]</sup>,因此,水晶电导率与晶体中 Na含量正 相关。

指前因子 A 由下式决定<sup>[11]</sup>:

 $A = (q_{\rm M}/2)^{1/2} N_0 e^2 V_0' d^2 / K$ 

其中:  $q_a$  为总碱含量,  $V_0$  为振动频率, d 为跃迁距 离, 其他同上。此处, 总碱含量即为水晶中 N a的 含量, 在相同温压条件下  $V_{-x} (d, N_0)$ 等均为常数, 因此, A 与晶体中 N a的总含量呈正相关关系, 故 gA 的变化趋势与 N a A l含量的变化趋势一致。

## 3 结 论

通过在 2.0 GPa和 823~1123 K 下借助交流 阻抗谱法在  $10^1 ~ 10^6$  H z频率范围内对水晶 Z 轴 方向的电导率就位测量,以及水晶中杂质 Na A l 的含量的 IA-ICP-M S测量,我们发现高温高压下 水晶电导率受其杂质 Na A l含量的影响很大,且 呈正相关关系;此外,指前因子变化趋势与 Na A l 含量的变化趋势一致。

#### 参考文献:

- [1] 谢鸿森.地球深部物质科学导论[M].北京:科学出版社, 1997. 42-45.
- [2] 谢鸿森,周文戈,刘永刚,等.地球深部物质的某些物性测量方法研究[J].地学前缘,2003,10(2):357-365.
- [3] 潘兆橹.结晶学与矿物学[M]. 武汉:中国地质大学出版社, 1993: 67-76.
- [4] Wang D J LiH P, LIU C Q, et al Electrical conductivity of synthetic quartz crystals at high temperature and high pressure from complex in pedance m easurem ents[J]. Chin Phys Lett, 2002, 19 1211–1213
- [5] 代立东,李和平,单双明,等 高温高压下 Z轴水晶的电导率实验研究 [J]. 人工晶体学报, 2005, 34:403-407.
- [6] Bagdassarov N S, D el p ine N.  $\alpha$ - $\beta$  inversion in quartz from low frequency electrical in pedance spectroscopy [J]. Journal of Physics and Chamistry of Solids 2004, 65(8-9): 1517-1526
- [7] Xu JA, Zhang YM, Hou W, et al. M essurements of ultrasonic wave velocities at high temperature and high pressure for window glass, pyrophylite and kimberlite up to 1400 °C and 5. 5 GPa[J]. High Temperature-High Pressure, 1994, 26: 375-384
- [8] 柳小明,高山,袁洪林,等. 193 m LA-ICPMS对国际地质标准参考物质中 42种主量和微量元素的分析 [J]. 岩石学报, 2002, 18 408-418.
- [9] N istan U. Stability field of olivine with respect to oxidation and reduction [J]. Journal Geophysical Research, 1974, 79(5): 706-711
- [10] Nowick A S. Stanley M W. Dielectric relaxation due to the A+Na defect in a quartz[J]. JApp lPhys, 1969, 40 4995-4997.
- [11] Jain H, Nowidk A S. Electrical conductivity of synthetic and natural quartz crystals J]. J Appl Phys 1982, 53: 477-484

## INFLUENCE OF IONIC IMPURITIES ON THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SYNTHETIC QUARTZ CRYSTALS AT HIGH TEMPERATURE AND HIGH PRESSURE

SHAN Shuang-ming<sup>1, 2</sup>, LIH e-ping<sup>1</sup>, DAILi-dong<sup>1</sup>, WANG Ri-ping<sup>1, 2</sup>

(1 Laboratory for Study of the Earth's Interior and Geofluids, Institute of Geochenistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China;

2 Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China)

**Abstract** Ionic inpurity is the most important factor affecting the electrical conductivity of synthetic quartz crystals. We measured the electrical conductivity of synthetic quartz crystals using the AC  $(10^{1} - 10^{6} \text{ Hz})$  complex impedance method in the temperature range between 823 and 1123 K at the pressure of 2.0 GPa. Using the method of LA-ICP-MS, the contents of N a and A l in the study quartz crystals were measured. By fitting the pbts of lg<sup>o</sup>T vs 1/T, we got the pre-exponential factor and activation energy at 2.0 GPa and 823 – 1123 K. It was found that the contents of N a increased with increasing contents of A l and in advance, with increasing contents of N a both the electrical conductivity and pre-exponential factor tended to increase

Keywords high temperature and high pressure, quartz crystal, electrical conductivity, ion ic inpurity.

112